

Rec'd PCT/PTO 18 JAN 2003

10/500 8/6
PCT/JP03/00020

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 03 MAR 2003
06.01.03
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 1月 8日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-001775

[ST.10/C]:

[JP2002-001775]

出 願 人

Applicant(s):

ティーディーケー株式会社

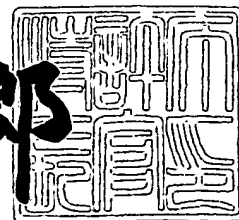
BEST AVAILABLE COPY

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 2月12日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3006542

【書類名】 特許願

【整理番号】 TD0089

【提出日】 平成14年 1月 8日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G11B 7/26

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

 【氏名】 小宅 久司

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

 【氏名】 高畑 広彰

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

 【氏名】 米山 健司

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

 【氏名】 川口 裕一

【特許出願人】

 【識別番号】 000003067

 【氏名又は名称】 ティーディーケイ株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100076129

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 松山 圭佑

【選任した代理人】

【識別番号】 100080458

【弁理士】

【氏名又は名称】 高矢 諭

【選任した代理人】

【識別番号】 100089015

【弁理士】

【氏名又は名称】 牧野 剛博

【選任した代理人】

【識別番号】 100112689

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐原 雅史

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 006622

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光記録媒体製造用スタンプの製造方法、スタンプ及びフォトレジスト原盤

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に、少なくとも光吸収層及びフォトレジスト層を、この順で形成し、該フォトレジスト層に、前記光吸収層と接する面の反対の面から光を照射して潜像を形成し、この潜像を現像することにより凹凸パターンを形成してフォトレジスト原盤を製造する工程と、前記フォトレジスト原盤における前記凹凸パターン上に金属薄膜を形成する工程と、該金属薄膜上に金属膜を形成し、前記金属薄膜及び金属膜を前記フォトレジスト原盤から剥離してスタンプを形成する工程と、前記フォトレジスト層に前記金属薄膜を形成する工程の前処理として、前記凹凸パターン表面に金属触媒を付与すると共に該金属触媒を活性化させる工程、及び前記金属触媒が付与された前記凹凸パターン表面を液体によって洗浄する工程を有することを特徴する光記録媒体製造用スタンプの製造方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、前記洗浄に用いる前記液体として純水を用いることを特徴とする光記録媒体製造用スタンプの製造方法。

【請求項 3】

予め表面に凹凸パターンが形成される光記録媒体製造用のスタンプであって、請求項 1 又は 2 に記載された製造方法によって製造されたことを特徴とするスタンプ。

【請求項 4】

基板と、該基板上に積層される光吸収層と、該光吸収層に接して積層され且つ潜像の形成及びその現像によって凹凸パターンが形成可能とされるフォトレジスト層と、を有し、前記フォトレジスト層に形成される前記凹凸パターン表面に、活性化された金属触媒が付与されていると共に、前記金属触媒付与後の該凹凸パターン表面が液体によって洗浄されていることを特徴とするフォトレジスト原盤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、グループやプリピットなどの凹凸パターンを有する光記録媒体を製造する際に用いるスタンプ、該スタンプ製造用のフォトレジスト原盤及び前記フォトレジスト原盤を用いるスタンプの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

光記録媒体の一種である光ディスクには、現在、追記又は書き換え等が可能な光記録ディスクと、予め情報が記録されている再生専用ディスクの2種類が存在する。

【0003】

光記録ディスクにおけるディスク基板にはトラッキング等に利用されるグループ（案内溝）が形成されており、更にこのディスク基板上に相変化材料や有機色素材料を含有する記録層が積層される。レーザービームを記録層に照射すると、該記録層が化学変化や物理変化を起こして記録マークが形成される。一方、再生専用ディスクのディスク基板上には、予め記録マーク（情報ピット）が凹凸パターンの一部として形成されている。これらの記録マークに読取用のレーザービームが照射されると光反射量の変動し、この変動を検出することによって情報の読み取り（再生）が可能となっている。

【0004】

グループや情報ピット等の凹凸パターンを有するディスク基板を製造するには、この凹凸のネガパターン（これも凹凸パターンの一種である）が予め形成されているスタンプを用いる。例えば、キャビティー内に上記スタンプが固定された金型を用いて射出成型を行い、充填された樹脂に上記ネガパターンを転写してディスク基板を製造する方法が一般的である。

【0005】

凹凸パターンを有するスタンプは、通常、Ni等を含む金属プレートによって構成される。このスタンプを製造する工程として、先ず、上記スタンプの凹凸パ

ターンのネガパターンを有するフォトレジスト原盤を予め作成しておき、このフォトレジスト原盤上にメッキによって金属膜を形成する。その後、フォトレジスト原盤から前記金属膜を剥離し、表面洗浄等の所定の処理を行うことでスタンプを得る。

【0006】

図7に示される従来のフォトレジスト原盤1を参照しながら、このフォトレジスト原盤1の製造工程について説明する。まず、ガラス基板2上にフォトレジスト層4を形成する。次に、レーザー等のパターンニング用ビームを用いてフォトレジスト層4を露光し、その潜像パターンを現像する。これによって凹凸パターン6がフォトレジスト層4に形成されたフォトレジスト原盤1が得られる。

【0007】

このフォトレジスト原盤1を用いてメッキによってスタンプ20を作成するには、図8に示されるように、先ず凹凸パターン6の表面にNi材料等を含んだ金属薄膜8を無電解メッキなどによって形成し、フォトレジスト原盤1に導電性を付与する。

【0008】

その後、この金属薄膜8を下地として通電させてメッキを行い、Ni等を含んだ金属膜10を形成する。これらの金属薄膜8及び金属膜10をフォトレジスト原盤1から剥離すれば、凹凸パターン6が転写されているスタンプ20を得ることが出来る。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

近年、光記録媒体の大容量化に伴ってグループ等の凹凸パターンが微細化し、その形状誤差が記録・読み取り精度に大きな影響を及ぼすようになってきている。従って、シャープな凹凸パターンをディスク基板に形成することが要求されるが、そのためには、基礎となるフォトレジスト層4の凹凸パターンを高精度（シャープ）に形成する必要がある。

【0010】

フォトレジスト層4に形成される潜像パターンの最小幅は、該フォトレジスト

層4に到達するレーザービームのスポット径によって制限される。スポット径 w は、レーザー波長を λ 、照射光学系の対物レンズの開口数を NA としたとき、 $w = k \cdot \lambda / NA$ で表される。なお、 k は対物レンズの開口形状及び入射光束の強度分布によって決定される定数である。

【0011】

ところで、スポット径の限界を論理的には超えない幅のパターンであっても、フォトリソ層4が薄かったりすると、スタンプに転写される凹凸パターンが浅かったり、凹凸パターンの形状が丸みを帯びてしまったり（これをパターンの「ダレ」という）して、シャープさが不足することが知られている。これは、一般的に露光・現像作業中にフォトリソ層4の厚さに変動が生じてしまう（これを「膜減り」という）ことが原因であると考えられている。この厚さ変動は、フォトリソ層4とガラス基板2の間でレーザービームが反射して、この反射光によってフォトリソ層4が必要以上に露光されてしまうことが原因と考えられていた。

【0012】

この問題を解決するためには、ガラス基板2とフォトリソ層4の間に光吸収層を形成することが効果的であることを本発明者は明らかにしている。このようにすると、光吸収層がレーザービームを吸収して光反射を抑制することが出来るので、従来と比較してよりシャープに露光・現像することが可能となる。

【0013】

しかしながら、本発明者は、更なる研究により、光吸収層を有するフォトリソ原盤1は、無電解メッキによる金属薄膜8の形成状態について問題を有することに気が付いた。具体的には、光吸収層が部分的に露出しているフォトリソ原盤1は無電解メッキ工程中に微小凹凸（微小欠陥）が増大する可能性を有することが推測された。即ち、同じように金属薄膜を形成しようとしても何らかの原因によって剥離後のスタンプの凹凸パターン表面に、微小凹凸（微小欠陥）が形成される場合があることが判明した。この微小凹凸は再生時にノイズとなって顕れてしまうので、光吸収層を有効活用して記録容量を増大させようとしても、かえって記録・再生性能が低下するという問題を有していた。

【0014】

この問題点を解決すれば、光吸収層を利用したフォトレジスト原盤によってシャープな凹凸パターンを有するスタンプが製造可能となる。即ち、光吸収層の利点によって原盤にシャープに形成された凹凸パターンを、忠実にスタンプに転写することができることが明らかとなった。

【0015】

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、無電解メッキ工程中に形状誤差が増大しないようにしたフォトレジスト原盤の製造方法、フォトレジスト原盤及びこれを用いて製造したスタンプを提供することを目的としている。

【0016】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、光記録媒体の製造方法等について鋭意研究を重ね、スタンプに凹凸パターンをシャープに形成する方法を発案した。即ち以下に示す発明によって、上記目的を達成することが可能となっている。

【0017】

(1) 基板上に、少なくとも光吸収層及びフォトレジスト層を、この順で形成し、該フォトレジスト層に、前記光吸収層と接する面の反対の面から光を照射して潜像を形成し、この潜像を現像することにより凹凸パターンを形成してフォトレジスト原盤を製造する工程と、前記フォトレジスト原盤における前記凹凸パターン上に金属薄膜を形成する工程と、該金属薄膜上に金属膜を形成し、前記金属薄膜及び金属膜を前記フォトレジスト原盤から剥離してスタンプを形成する工程と、を有し、前記フォトレジスト層に前記金属薄膜を形成する工程の前処理として、前記凹凸パターン表面に金属触媒を付与すると共に該金属触媒を活性化させる工程、及び前記金属触媒が付与された前記凹凸パターン表面を液体によって洗浄する工程を有することを特徴する光記録媒体製造用スタンプの製造方法。

【0018】

(2) 上記(1)において、前記洗浄に用いる前記液体として純水を用いることを特徴とする光記録媒体製造用スタンプの製造方法。

【0019】

(3) 予め表面に凹凸パターンが形成される光記録媒体製造用のスタンプであって、上記(1)又は(2)に記載された製造方法によって製造されたことを特徴とするスタンプ。

【0020】

(4) 基板と、該基板上に積層される光吸収層と、該光吸収層に接して積層され且つ潜像の形成及びその現像によって凹凸パターンが形成可能とされるフォトリジスト層と、を有し、前記フォトリジスト層に形成される前記凹凸パターン表面に、活性化された金属触媒が付与されていると共に、前記金属触媒付与後の該凹凸パターン表面が液体によって洗浄されていることを特徴とするフォトリジスト原盤。

【0021】


本発明者は、光吸収層を用いたフォトリジスト原盤に金属触媒を付与するようにした。その結果、光吸収層の利点と金属触媒付与による相乗効果によって従来と比較してシャープな凹凸パターンを形成できることを確認した。光吸収層が部分的に露出しているフォトリジスト原盤は無電解メッキ工程中に微小凹凸（微小欠陥）が増大する可能性を有するとの着眼の下、本発明者の更なる解析によって、金属触媒付与後の凹凸パターン表面を液体によって洗浄することで、より一層微細な凹凸パターンを高精度に形成できることが判明した。

【0022】

この理由としては次のように考えられるが、これはあくまでも推定理由である。

【0023】

金属触媒の付与後にアクセラレータでSnを除去する際に、このアクセラレータが、部分的に露出している光吸収層に染み込んで行き、ガラス基板表面にまで達する。すると、ガラス基板上に通常設けられるカップリング剤層がこのアクセラレータと何らかの反応を起こしてガスが発生し、微小凹凸を形成してしまう。本発明では、アクセラレータの工程の後、液体で洗浄することによりこのアクセラレータを洗い流すので、微小凹凸は発生しない。この結果、光吸収層の特性によってシャープに露光された凹凸パターンを、無電解メッキによって形成される



金属薄膜に正確に再現することが可能となっている。

【 0 0 2 4 】

以上の結果、光記録媒体のグルーブや情報ピット等もシャープに形成されるので、記録・再生特性を向上させることが出来る。又、今後益々進展する凹凸パターンの微細化にも対応可能となることから、光記録媒体の情報記憶（記録）容量を増大させることもできる。

【 0 0 2 5 】

【発明の実施の形態】

以下本発明の実施形態の例について図面を参照して詳細に説明する。

【 0 0 2 6 】

図 1 に、本発明の実施形態の例に係るフォトレジスト原盤 1 0 0 を示す。このフォトレジスト原盤 1 0 0 は、ガラス基板 1 0 2 と、このガラス基板 1 0 2 上に積層される光吸収層 1 0 3 と、この光吸収層 1 0 3 上に積層されるフォトレジスト層 1 0 4 と、を備える。なお、ガラス基板 1 0 2 の表面は、光吸収層との密着性向上のためカップリング剤等で処理されている。前記フォトレジスト層 1 0 4 は、光吸収層 1 0 3 の反対側（図 1 において上側）からパターンニング用レーザービームにより露光されることによって凹凸パターンの潜像が形成され、この潜像の現像によって一部が除去されて凹凸パターン 1 0 6 が形成されている。なお、現像後は、凹凸パターン 1 0 6 の凹部の底面に光吸収層 1 0 3 の一部が露出していることになる。図 1 の符号 1 0 7 は凹凸パターンが形成されていない領域である非凹凸領域を示す。

【 0 0 2 7 】

なお、後述のように、前記凹凸パターン 1 0 6 はスタンプ 1 2 0 のパターン面 2 0 6 となる。又、凹凸パターンが形成されていない領域はスタンプ 1 2 0 のミラー面 2 0 7 となる。

【 0 0 2 8 】

前記露光の際は、パターンニング用ビームが光吸収層 1 0 3 によって吸収されて光反射が抑制され、微細な凹凸をシャープに形成することが可能となっている。

【 0 0 2 9 】

このフォトリジスト原盤100における凹凸パターン106表面にはPd (106A) が付与されている。具体的には、金属触媒であるキャタリスト (Pd-Sn化合物) を凹凸パターン106の表面に吸着させると共に、アクセラレータを用いてキャタリストを活性化させ、Snのみを除去することで凹凸パターン106表面にPdを析出させる。その後、Pdが付与された凹凸パターン106の表面を液体によって洗浄する。具体的には、純水、好ましくは超純水を用いて凹凸パターン106の表面を水洗することで、微小凹凸の発生を抑制することができる。超純水の流量は好ましくは1 l/min以上、より好ましくは、5 l/min以上とする。なお、ここでは金属触媒としてPd-Sn化合物を用いたが、本発明はそれに限定されず他の金属触媒を用いても構わない。

【0030】

また、図1では、Pd (106A) の付与状態を膜状にして模式的に示しているが、現実の付与状態を表わすものでない。

【0031】

図2 (A) には、上記フォトリジスト原盤100を用いてスタンパ120を形成した状態を示す。

【0032】

この形成工程では、まず、Pdが析出されている凹凸パターン106表面に、無電解メッキによってNi薄膜108を形成する。

【0033】

この際、メッキ溶液中の還元剤が、触媒活性特性を有するPd表面で酸化されるときに電子を放出するので、その電子によって溶液中のNiイオンが還元され、Ni薄膜108が凹凸パターン106に効果的に馴染むようになっている。特に、本実施形態の例では凹凸パターン106の凹部にも十分なPdが付与されているので、その凹凸パターン106に忠実に沿ってNi薄膜108を形成することが出来る。

【0034】

その後、Ni薄膜108を下地として表面を通電させ、電気メッキによってNi膜110を形成する。Ni薄膜108とNi膜110をフォトリジスト原盤1

00から剥離させると、図2（B）のように凹凸パターン106が正確に転写されたスタンプ120を得ることが出来る。このとき、前記Pd（106A）は、Ni薄膜108側に付着している。

【0035】

前記スタンプ120において、前記凹凸パターン106の領域に対応してはパターン面206が、又、非凹凸領域107に対応してミラー面207が、それぞれ形成されている。

【0036】

なお、特に図示しないが、光ディスク基板を製造するには、上記スタンプ120を金型に設置して射出成型等によって製造する。又このスタンプ120を用いて光ディスク基板を製造する以外にも、該スタンプ120をマスタ盤とした電鍍工程によってマザー盤を作成し、このマザー盤で光ディスクを製造しても良い。

【0037】

更に、このマザー盤を原盤としてチャイルド盤を作成し、これで光ディスクを製造しても良い。即ち、本発明におけるスタンプ120とは、実際に光ディスクの製造に直接利用される場合に限られず、これをマスタ盤としてマザー盤などを作成することによって光ディスクの製造に間接的に用いるものであっても構わない。

【0038】

本実施形態の例のフォトレジスト層104では、光吸収層103を積層することによって鮮明な潜像を描くことが可能となり、シャープな凹凸パターン106を得ることが出来る。それに加えて、無電解メッキの前処理として予め当該凹凸パターン106にPdを付与し、更にその表面を水洗しているので、凹凸パターン106の形状に沿った正確なNi薄膜108を形成することが可能となっている。つまり、光吸収層103の利点を出来る限り生かすように考慮されている。

【0039】

これらの光吸収層103とPd付与による相乗効果によって、シャープな凹凸パターン106をシャープな状態のままスタンプ120に転写することができ、結果として、スタンプ120に形成される凹凸パターンの「ダレ」が抑制される

。しかも、スタンパ120に転写された凹凸パターン表面は従来よりも滑らかであり、微小凹凸（微小欠陥）の数が大幅に低減している。このスタンパ120を利用すれば、ノイズが抑制された記録・読み取り（再生）精度の高い光記録媒体を得ることが出来る。

【0040】

なお、光吸収層が露出する前に露光を止める場合にも、Pd付与と光吸収層による相乗効果は得られるので、上記と同様にシャープな凹凸パターンをシャープな状態のままスタンパに転写することができる。

【0041】

また、本実施形態ではNiを用いたメッキ処理についてのみ説明したが、本発明はそれに限定されるものではなく、他の金属メッキを利用してもよい。

【0042】

【実施例】

（実施例：スタンパNo. 1）

研磨されたガラス基板上にカップリング剤層を形成した後、光吸収層をスピコート法により形成した。塗布液には4,4'-ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノン（東京応化工業（株））を用いた。この塗膜を200度で15分間ベーキングして硬化すると共に残留溶剤を除去し、厚さ140nmの光吸収層とした。次いで、この光吸収層上に、フォトレジスト（日本ゼオン（株）製DVR100）をスピコートし、ベーキングにより残留溶剤を蒸発させて、厚さ25nmのフォトレジスト層とした。

【0043】

その後、ソニー（株）製カッティングマシンを用い、トラックピッチ320nm、グループ幅150nmのグループパターンの形成を目的として、Krレーザ（波長＝351nm）によってフォトレジスト層に対し露光を行い、更に現像を行うことで凹凸パターンを形成して、フォトレジスト原盤を得た。

【0044】

このフォトレジスト原盤のフォトレジスト層表面を界面活性剤で活性化した後、無電解メッキの前処理として、キャタリスト（Pd、Snコロイド）を付与し

た。次いでアクセラレータ(HBF_4 溶液)によりSnを除去するとともに表面にPdを析出させ、その後、超純水(水量; 12 l/min)によって凹凸パターン表面を水洗し、無電解メッキの下準備が完了したフォトレジスト原盤を得た。

【0045】

次いで、このフォトレジスト原盤を NiCl_2 浴に浸漬し、無電解メッキによりNi薄膜を形成した。このNi薄膜を下地として電気メッキを行い、Ni膜を形成した。これらのNi薄膜およびNi膜からなる積層体を原盤から剥離し、裏面研磨、表面洗浄を行って、スタンプNo. 1を得た。

【0046】

(比較例:スタンプNo. 2)

水洗しないという条件を除き、スタンプNo. 1作製の際と同様にしてスタンプNo. 2を作製した。

【0047】

(比較例:スタンプNo. 3)

光吸収層がないという条件を除き、スタンプNo. 1作製の際と同様にしてスタンプNo. 3を作製した。


【0048】

(評価結果1)

各スタンプに形成された凹凸パターンについて、AFM(原子間力顕微鏡)を用いて形状を確認した。AFMの探針は窒化シリコン(SiN)針を用いた。測定はノンコンタクトモードにて行い、サンプルとプローブ間の原子間力の変化を画像化した。

【0049】

図3(A)にスタンプNo. 1のAFM像を、図3(B)に同断面形状を線図によりそれぞれ示す。又、図4(A)にスタンプNo. 3のAFM像を、図4(B)に同断面形状を線図によりそれぞれ示す。AFM像において、描点の密度が高い領域が凹凸パターンにおける凹部であり、描点の密度が低い、あるいは白抜きの領域が凸部であり、フォトレジスト原盤における凹凸パターンの凸部及び凹部にそれぞれ対応している。又、図3(B)、図4(B)では、凹凸が $0.32\mu\text{m}$



mピッチで形成されている。

【0050】

図3、図4を比較すれば明らかなように、本発明を適用して製造されたスタンパNo. 1では、光吸収層の効果によりシャープなパターンが形成され、Pd付与及び水洗処理の効果によってそのパターンを忠実に転写したことがわかる。

【0051】

(評価結果2)

走査型電子顕微鏡(10000倍)で、スタンパNo. 1およびスタンパNo. 2を測定した凹凸状態を図5及び図6に、それぞれ示す。この図5、図6の比較から、スタンパNo. 1では微小凹凸が見られないが、スタンパNo. 2では横軸3 μ m付近と8.5 μ m付近に、幅1 μ m程度の凹みとして微小凹凸が明確に認められることがわかる。なお、図5、6の約0.3 μ mピッチの凹凸は本発明において形成すべき凹凸パターンである。

【0052】

【発明の効果】

本発明では、フォトレジスト層に接した光吸収層によって、シャープな凹凸パターンをフォトレジスト原盤に形成でき、更に、凹凸パターン表面に付与されるPd及び洗浄工程によりこの凹凸パターンに忠実なパターン面を有するスタンパを得ることが可能となった。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態の例に係るフォトレジスト原盤を示す断面図

【図2(A)】

同フォトレジスト原盤を用いてスタンパを製造途中の状態を示す断面図

【図2(B)】

同製造されたスタンパを示す断面図

【図3(A)】

本発明の実施例に係るスタンパに形成された凹凸パターンをAFMによって解析した状態を示す図

【図3 (B)】

同AFM解析に基づく凹凸パターンの断面形状を示す線図

【図4 (A)】

本発明の比較例に係るスタンプに形成された凹凸パターンをAFMによって解析した状態を示す図

【図4 (B)】

同AFM解析に基づく凹凸パターンの断面形状を示す線図

【図5】

上記実施例のスタンプ表面を走査型電子顕微鏡で測定した凹凸状態を示す線図

【図6】

上記比較例のスタンプ表面を走査型電子顕微鏡で測定した凹凸状態を示す線図

【図7】

従来のフォトリソト原盤を示す断面図

【図8】

従来のフォトリソト原盤を用いてスタンプを製造する状態を示す断面図

【符号の説明】

100…フォトリソト原盤

102…ガラス基板

103…光吸収層

104…フォトリソト層

106…凹凸パターン

107…非凹凸領域

108…Ni薄膜

110…Ni膜

120…スタンプ

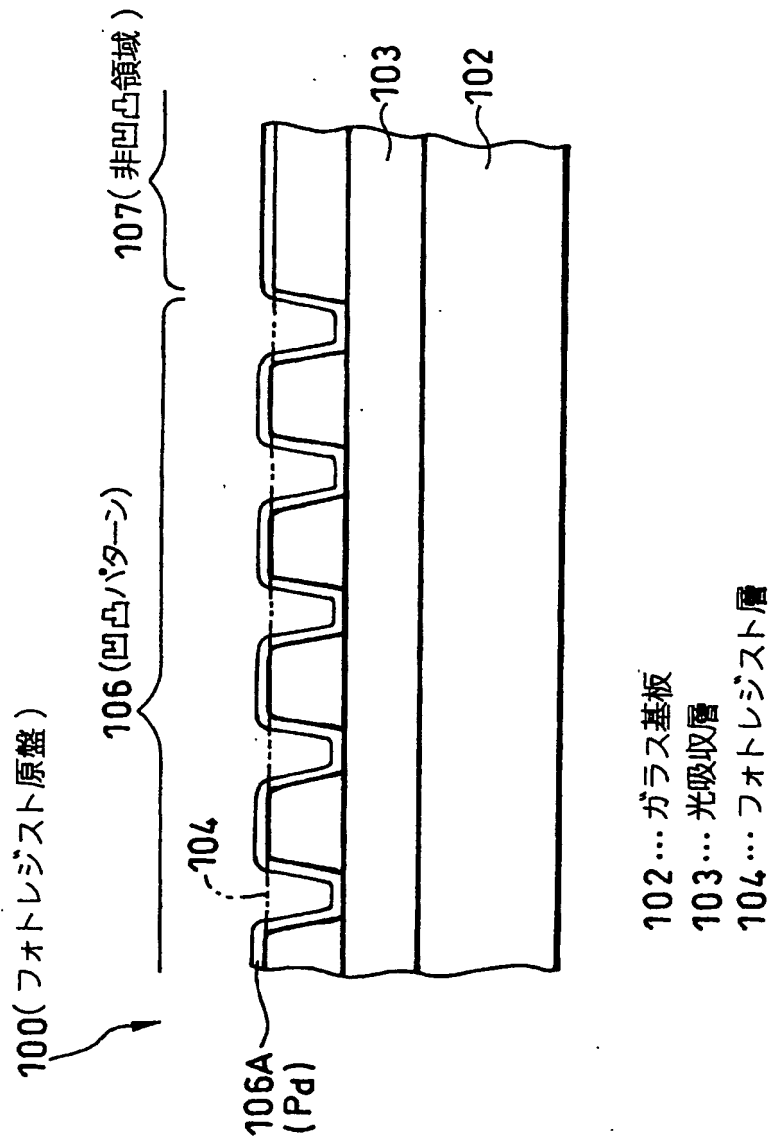
206…パターン面

207…ミラー面

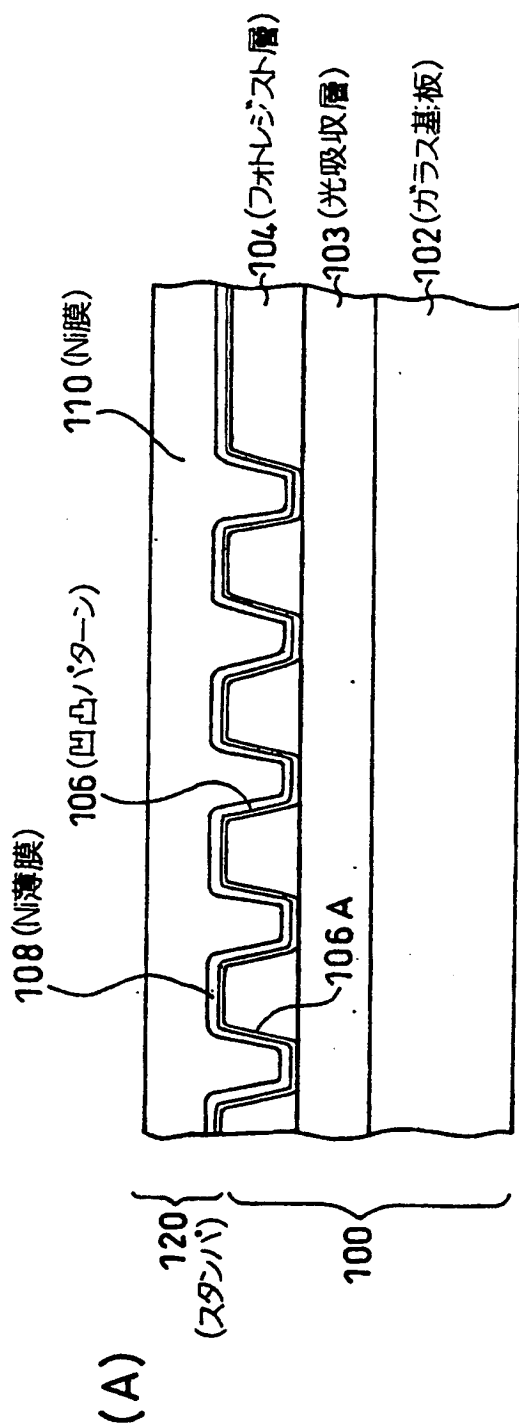
【書類名】

図面

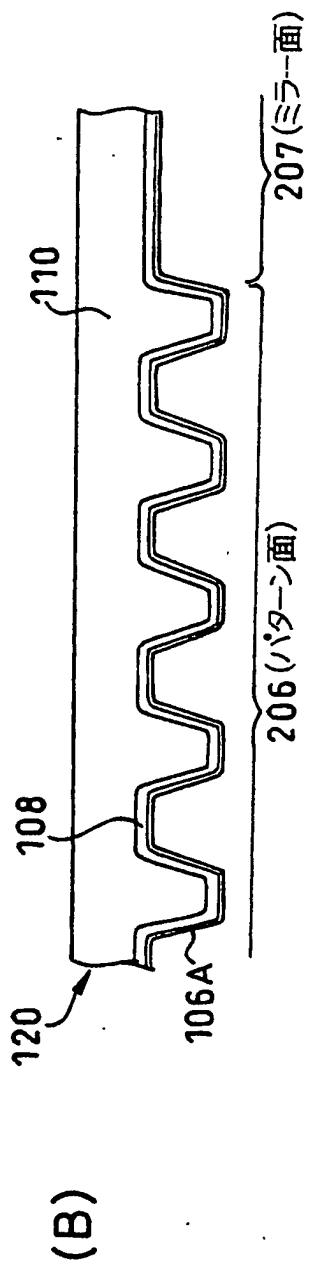
【図 1】



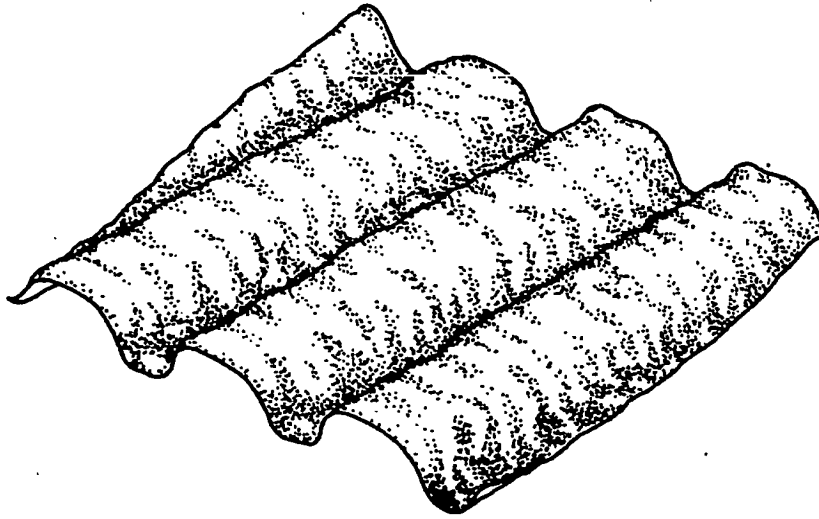
【図 2 (A)】



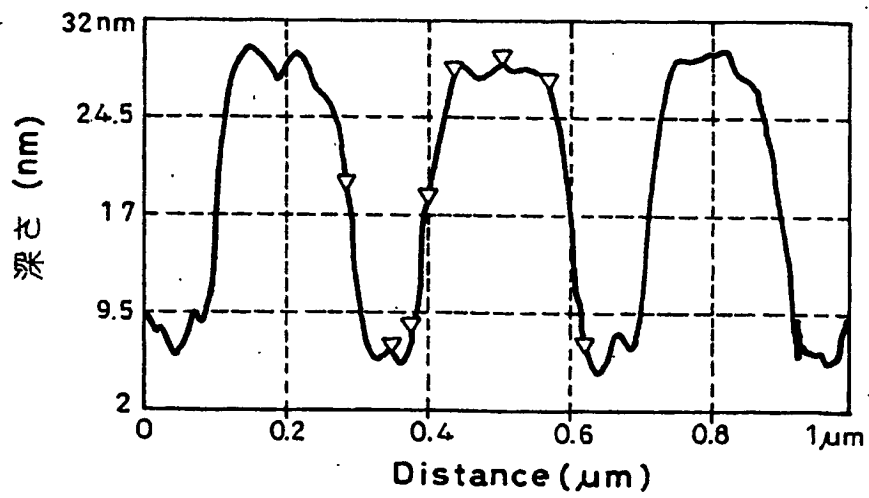
【図2 (B)】



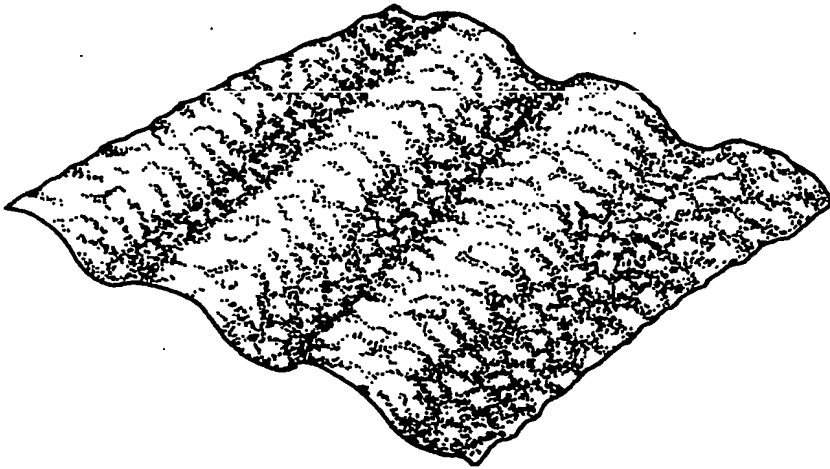
【図 3 (A)】



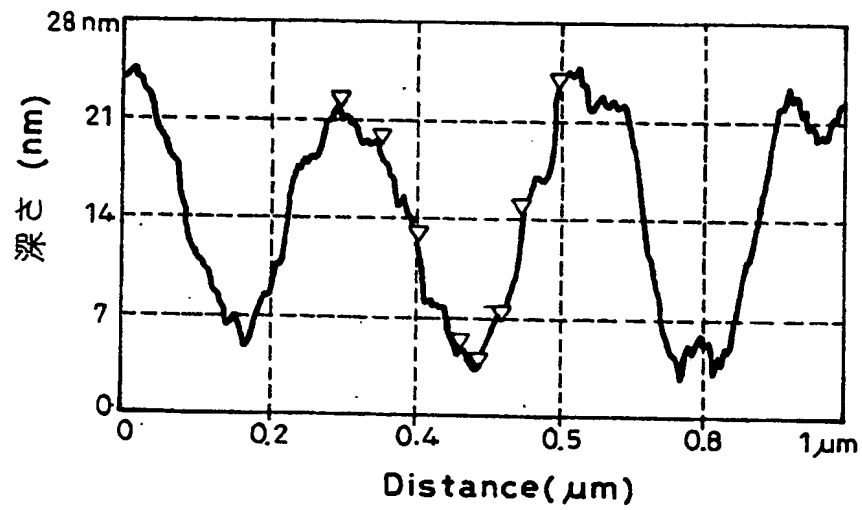
【図 3 (B)】



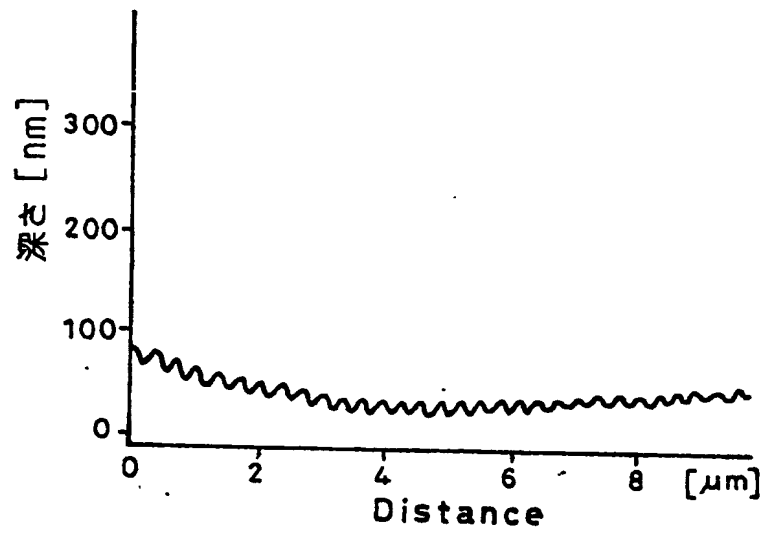
【図 4 (A)】



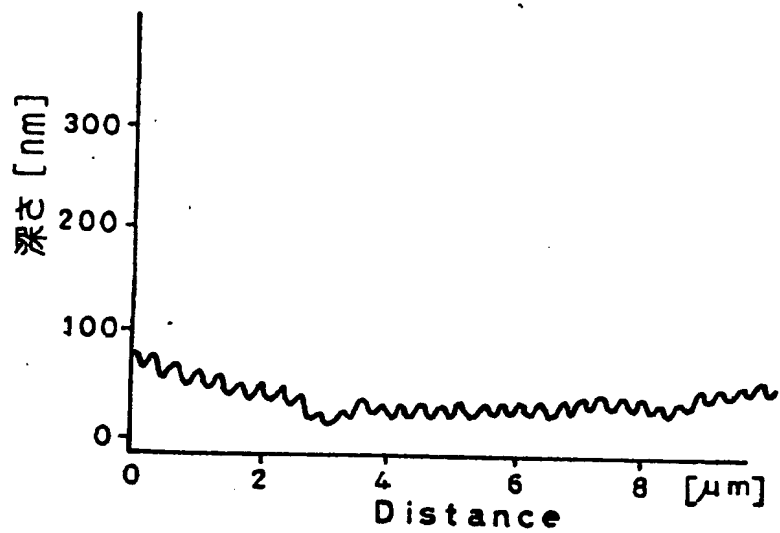
【図 4 (B)】



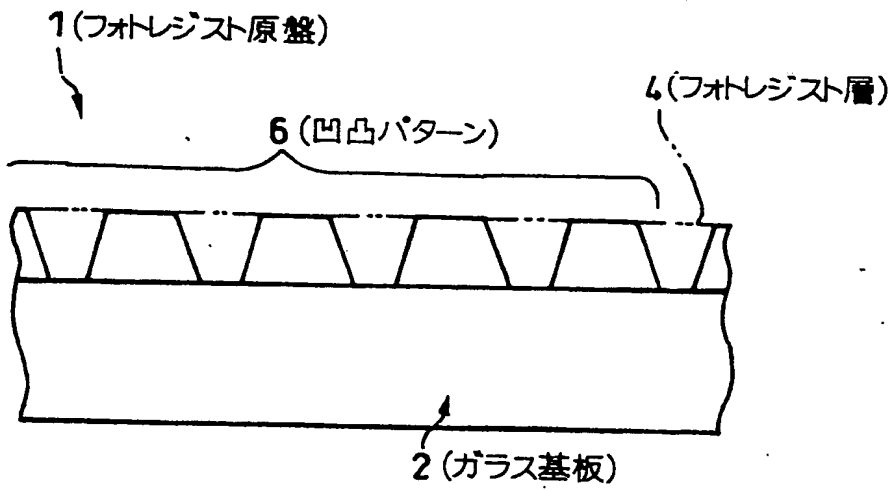
【図 5】



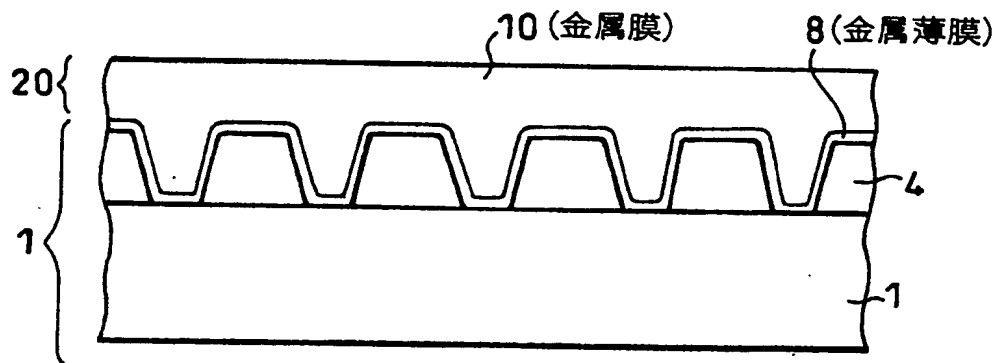
【図 6】



【図 7】



【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 シャープな凹凸パターンが形成されたスタンプを得て、且つ、該スタンプを用いて高精度の光記録媒体を製造可能とする。

【解決手段】 基板 1 0 2 上に光吸収層 1 0 3、フォトレジスト層 1 0 4 を形成し、フォトレジスト層 1 0 4 に潜像を形成し、それを現像して凹凸パターン 1 0 6 を形成してフォトレジスト原盤 1 0 0 を製造し、フォトレジスト原盤 1 0 0 の凹凸パターン上 1 0 6 に無電解メッキにより Ni 薄膜 1 0 8 を形成し、Ni 薄膜 1 0 8 上に Ni 膜 1 1 0 を形成し、Ni 薄膜 1 0 8 と Ni 膜 1 1 0 をフォトレジスト原盤 1 0 0 から剥離してスタンプ 1 2 0 を形成するスタンプ製造方法であって、フォトレジスト層 1 0 4 に Ni 薄膜 1 0 8 を形成する工程の前処理として、凹凸パターン 1 0 6 表面に金属触媒を付与し、且つ、この金属触媒を活性化させ、金属触媒が付与された凹凸パターン表面 1 0 6 を超純水等によって洗浄する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都中央区日本橋1丁目13番1号
氏 名	ティーディーケイ株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.